بررسی اثر افزودن همزمان کاربید سیلیسیم (SiC) در دو مقیاس نانو و میکرون بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار زینتر بدون فشار کامپوزیت های فوق دما بالای بر پایه دیبورید زیر کونیوم (ZrB₂)

زینب نصیری^۱، مهری مشهدی^۲* ۱- دانشجوی دکتری مهندسی مواد، مجتمع مواد و فناوری های ساخت دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران ۲- استادیار، عضو هیئت علمی مجتمع مواد و فناوری های ساخت دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران *عهده دار مکاتبات: me_mashadi@yahoo.com (تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵، تاریخ پذیرش:۱۳۹۵/۱۲/۱۱)

چکیده: در این تحقیق، نانو کامپوزیت ZrB₂-SiC به روش زینتر بدون فشار تولید گردید که در ترکیب اولیه کامپوزیت از ۲۰ درصد حجمی SiC نانو استفاده شد. به منظور ساخت نمونهها، پودر ZrB₂ و پودرهای SiC نانو و میکرون در درصدهای حجمی مختلف در آسیاب سیاره ای آسیاب شده و مخلوط پودری گرانوله شده پس از پرس گرم اولیه در دمای ۵۰۰ و فشار ۱۰۰MPa تحت فرآیند پرس ایزواستاتیک سرد (CIP) قرار گرفت. در نهایت عملیات زینتر در دمای ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. برای مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی نمونهها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به طیفسنج CIS، آنالیز XRD آزمون سختی و تافنس شکست استفاده شد. دانسیته نسبی نمونهها نیز به روش ارشمیدس محاسبه گردید. نتایج حاصل شده از تمامی نمونهها در ترکیبات مختلف نشان میدهند که با تغییر درصد حجمی Sic نانو از ۲۰ درصد حجمی به ۱۰ درصد و ۵ درصد میکرون، افزایش در دانسیته تا ۸۵۱ درصد رخ می دهد. با بررسی ریز ساختاری و اندازه گیری خواص مکانیکی نمونه ها بیشترین میکرون، افزایش در دانسیته تا ۸۵۱ درصد رخ می دهد. با بررسی ریز ساختاری و اندازه گیری خواص مکانیکی نمونه ها بیشترین میکرون، افزایش می میمانیکی نمونه ها ترتیب ۱۵ و ۵ درصد حجمی Sic نانو و میکرون و با مقادیر ۱۵۹Gp و میماهده شد.

> **واژه های کلیدی:** نانو کامپوزیت ZrB₂-SiC، نانو ذرات SiC، کامپوزیت های فوق دما بالا، زینتر بدون فشار.

> > ۱ – مقدمه

ویژه ZrB₂ و HfB₂) در کاربردهایی که تحت تنشهای حرارتی هستند، بسیار مناسب باشند [۲]. یکی از سادهترین روشها در تولید کامپوزیتهای بر پایه ZrB₂ روش زینتر بدونفشاراست. به این صورت که پس از آمادهسازی مواد اولیه، مرحله شکلدهی در یک پرس تکمحوره صورت گرفته و قطعه بلافاصله وارد دستگاه پرس ایزواستاتیک سرد (CIP) می شود. این مرحله به منظور افزایش استحکام خام انجام در صنایع هوا فضا دو سرامیک ZrB₂ و HfB₂ را به عنوان سرامیکهای فوق دمای بالا می شناسند. این دو بورید دارای نقطه ذوب بالایی هستند (بیش از ۳۲۰۰ درجه سانتی گراد) [۱] و همچنین هدایت حرارتی و الکتریکی بالا، سختی بالا (GPa – ۲۲ ۱۱)، استحکام خوب و پایداری شیمیایی در دماهای بالا دارند. ویژگی های گفته شده برای دی بوریدها به ویژه هدایت حرارتی بسیار بالای آنها موجب شده است که استفاده از دی بوریدها (به

میگیرد. پس از مرحله مستحکمسازی نوبت به فرآیند زینتر میرسد. این فرآیند در دمای C°۲۰۰۰–۲۲۰۰ انجام میشود. به منظور تسهیل در فرآیند ساخت و در نتیجه بهبود خواص، در این روش از کمکزینتر استفاده میکنند. این کمک زینترها یا آنهایی هستند که تولید فاز مایع می کنند و یا آنهایی هستند که با حذف ناخالصي هاي اكسيدي فر آيند را بهبود ميبخشند [٣]. از میان افزودنی.های مورد استفاده در ساخت کامپوزیت.های بر پایه ZrB₂، SiC به دلیل خواص ویژه ای که دارد مورد توجه بیشتری در صنایع به خصوص صنعت هوافضا قرار گرفته است [۴]. کامپوزیت ZrB₂-SiC، در پوشش های مقاوم در دماهای بالا و مقاوم در برابر خوردگی واکسیداسیون، بو ته های ذوب فلزات، الكترودهاي دما بالا و پوشش هاي محافظ براي فولادها، ياتاقانهاي سراميكي، قطعات الكترونيكي، ابزارهاي برش، حفاظت حرارتی تجهیزات فراصوتی، المان،ای کوره، الكترودهاي قوس پلاسما، اجزاي موتور براي پروازهاي مافوق صوت، محافظ حرارتی برای وسایل نقلیه فضایی، پیشرانه موشک، به کار برده می شوند [۴-۵].

ثابت شده است که حضور فازهای ثانویه نانومتری در زمینه سرامیکی باعث افزایش چشمگیر در خواص کامپوزیت میشود. زیرا افزایش سطح در نانوپودرها منجر به افزایش نیروی محرکه برای انجام فرآیند زینتر میشود [۶]. البته این در صورتی است که توزیع ذرات نانومتری بطور یکنواخت صورت گرفته و تا حد ممکن از آگلومره شدن آنها جلوگیری شود. در چند سال اخیر گزارشهایی مبنی بر استفاده همزمان از ذرات تقویت کننده نانومتری و میکرومتری در پوششهای سرامیکی ارائه شده است. تقویت کننده در دو اندازه مختلف میتواند خواص مکانیکی را بهبود بخشد. اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر حضور همزمان ذرات Sic نانو و میکرون در کامپوزیت های بر پایه ZrB2 ارائه نشده است. بر همین اساس در این تحقیق، به منظور دستیابی به توزیع یکنواخت ذرات Sic نانو و شکسته شدن آگلومرهها،

پودر SiCnano به همراه SiC میکرون به عنوان فاز تقویت کننده در کامپوزیت بر پایه ZrB2 مورد استفاده قرار گرفت.

۲- مواد و روش انجام تحقيق

در این تحقیق، از روش زینتر بدون فشار برای تولید کامپوزیت ZrB2-SiC استفاده شد. پودر ZrB2 با متوسط اندازه ذرات ۱۰ میکرون به عنوان زمینه کامپوزیت مورد استفاده قرار گرفت. از پودرهای SiC نانو (با متوسط اندازه ذرات ۴۰ نانومتر) و SiC میکرون (با متوسط اندازه ذرات ۱۰ میکرون) نیز به عنوان فاز تقویت کننده استفاده شد. تصویر SEM پودرهای مورد استفاده در این تحقیق در شکل ۱ نشان داده شده است.

قبل از شروع مراحل ساخت نمونه ها پودر ZrB₂ در آسیاب سیارهای در محیط ایزوپروپانول با نسبت گلوله به پودر ۲:۱۰در مدت زمانهای ۳،۲،۱ و ۴ ساعت و با سرعت ۲۰۰rpm آسیاب شد. بیشترین کاهش اندازه ذره در مدت زمان آسیاب ۲ ساعت رخ داد، در مرحله بعد پودرهای SiC نانو و میکرون به طور همزمان به همراه ایزوپروپانول به پودر ZrB₂ آسیاب شده اضافه گردید. این فرآیند در آسیاب سیارهای در محیط ایزوپروپانول با نسبت گلوله به پودر ۲۰:۱ به مدت ۱ ساعت و با سرعت نسبت گلوله به پودر ۲۰:۱ به مدت ۱ ساعت و با سرعت سازی (dispersant) آلی را داشته و به شکسته شدن آگلومرهها میازی نده می کند. این تمهیدات به منظور دستیابی به توزیع یکنواخت تر ذرات SiC نانو و شکسته شدن آگلومرهها می باشد. در جدول ۱چگونگی نام گذاری نمونه ها و درصد حجمی فاز تقویت کننده آورده شده است.

مخلوط پودری گرانول شده تحت فشار تک محوره به میزان ۵۳۲۵–۸۰ به شکل قرص هایی با قطر ۱۰۳۳ و ارتفاع ۵۳۳۳ شکل دهی شد. سپس نمونه ها جهت افزایش استحکام خام تحت پرس ایزواستاتیک سرد با فشار bar ۲۰۰۰ قرار گرفت. پس از آماده سازی نمونه ها، عملیات حرارتی آنها در دو مرحله پیرولیز و زینتر انجام شد. فرآیند پیرولیز در یک کوره تحت اتمسفر آرگون با سرعت گرمایش ۰۲/۱۳ به مدت زمان ۶ ساعت در

دمای C°۱۰۰۰ انجام می شود. فر آیند زینتر بدون فشار در کوره با سرعت گرمایش C/min° ۱۰در دمای C°۲۱۵۰ به مدت زمان ۱ ساعت انجام شد.



شكل (۱): تصویر SEM مواد اولیه مورد استفاده در این تحقیق: (الف): ZrB2، (ب): SiC نانو و (ج): SiC میكرون

به منظور بررسی اثر حضور همزمان ذرات SiC نانو و میکرون بر رفتار زینتر بدون فشار نانوکامپوزیت ZrB2-SiC، مقادیر دانسیته نسبی نمونهها محاسبه گردید.

جدول (۱): نام و ترکیب نمونه های تولید شده در این تحقیق

درصد حجمي SiC نانو به	نام نمونه
ميكرون	
20nano/0micron	ZS20/0
15nano/5micron	ZS15/5
10nano/10micron	ZS10/10
5nano/15micron	ZS5/15

برای مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی نمونهها نیز از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به طیفسنج EDS، آنالیز XRD، آزمون سختی و تافنس استفاده شد. به منظور تعیین دانسیته نمونهها پس از فرآیند زینتر، از روش ارشمیدس (استاندارد ASTM C 373-88) استفاده شد. آزمون سختی مطابق با استاندارد ASTMC1327 با استفاده از دستگاه (fracture سختی سنج ویکرز صورت گرفت. تافنس شکست fracture) فرورونده ویکرز محاسبه گردید.

۳- نتایج و بحث ۳-۱- بررسی ریزساختار

در تحقیقات قبلی ثابت شد [۷] که حضور ۲۰ درصد حجمی فاز تقویت کننده نانو SiC در زمینه ZrB2 باعث افزایش چشمگیر در خواص کامپوزیت میشود. در این تحقیق، به منظور دستیابی به توزیع یکنواخت ذرات SiC نانو و شکسته شدن آگلومرهها، پودر SiCnano به همراه SiC میکرون در آسیاب سیارهای در محیط ایزوپروپانول آسیاب گردید. تصویر MES از مخلوط پودرosiCnano پس از آسیاب (شکل۲) نشان میدهد که نانو ذرات SiC در اطراف ذرات SiC میکرون تجمع کرده و به این ترتیب تا حدود زیادی از آگلومره شدن آنها جلو گیری به عمل آمده است.



شکل (۲): تصویر SEM از مخلوط پودری SiC-SiCnano پس از ۲ ساعت آسیاب

به عبارت بهتر ذرات SiC میکرون مانع آگلومره شدن بیش از حد نانوذرات شده است.به منظور بررسی و شناسایی فازهای تشکیل شده در حین زینتر از نمونههای ZS20 آنالیز XRD گرفته شد (شکل ۳). همانطور که دیده می شود، تنها فازهای ZrB₂ و SiC در نمونه وجود دارند. این نتایج نشان میدهد که طی فرآیند زینتر تا دمای ۲۱۵۰ درجه سانتی گراد، هیچ گونه واکنشی بین ZrB₂ و SiC رخ نداده است.

۲- توزیع ذرات SiC نانومتری در امتداد مرزدانه های زمینه (ناحیه



شکل (۳): الگوی پراش پرتو X از نمونه ZS20/0 پس از زینتر در دمای ۲۱۵۰ درجه سانتیگراد

۲)

بر اساس تصویر SEM در شکل ۴ پس از انجام فرآیند زینتر، در نمونههای حاوی ذرات SiC نانو و میکرون، دو نوع توزیع در نحوه پخش ذرات فاز تقویتکننده مشاهده میشود: ۱- توزیع (قرارگیری) ذرات SiC میکرون در محل تخلخلهای به وجود آمده در ناحیه تلاقی دانههای زمینه (ناحیه ۱)



شکل (۲): نحوه نوریع درات SIC نانومتری و میکرومتری در نمونه -EIBZ 15SiCnano-5SiC به همراه آنالیز EDS از فاز زمینه (نواحی روشن) و فاز تقویت کننده (نواحی تیره)

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که ذرات SiC میکرون با پر کردن تخلخلها به بهبود فرآیند چگالش و افزایش دانسیته کمک کرده و ذرات SiC نانو نیز با قرارگرفتن در مرزدانهها از رشد دانهها جلوگیری کرده و به این ترتیب باعث افزایش

خواص مکانیکی می شوند. علاوه بر دو ناحیه فوق، ذرات SiC نانو ممکن است در حین فرآیند زینتر در نواحی درون دانهای محبوس شوند. این نواحی که به آنها ساختار درون دانهای نیز گفته می شود در شکل ۵ نشان داده شده است.



شکل (۵): به دام افتادن نانوذرات SiC در داخل دانههای زمینه (ساختار درون دانهای)

در شکل ۶ نتایج حاصل از محاسبه دانسیته نسبی نمونه های حاوی فاز تقویت کننده SiC نانو و میکرون در دمای زینتر ۲۱۵۰°C آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود بهترین نتیجه در نسبت SiCnano/SiC = 15/5 به دست آمده است. بطوریکه دانسیته نسبی در این حالت (۹۵/۱) حتی از دانسیته نسبی نمونه های ZrB₂-20%vol SiCnano و ZrB₂-2 10% vol SiCnano (یعنی ۹۲/۸ و ۹۲/۴) نیز بیشتر است. این نشان می دهد که حضور همزمان ذرات SiC نانو و میکرون در زمینه ZrB₂ در مقایسه با نمونه هایی که فقط دارای ذرات تقویت کننده نانومتری هستند، تأثیر بسیار بیشتری بر بهبود خواص کامپوزیت دارد که این تنها با افزودن ۵ درصد حجمی SiC میکرون به دست آمد. این مسئله با توزیع غیر یکنواخت ذرات SiC نانو توجیه می شود [۸]. در نمونه های نانو با افزایش درصد حجمی SiC نانو، پدیده آگلومراسیون تشدید شده در نتیجه توزیع غیر یکنواخت نانو ذرات در مرز دانه بیشتر می شود، در نتيجه درصد تخلخل ظاهرى افزايش مىيابد، كه وجود ذرات میکرون به دلیل کاهش یدیده آگلومراسیون نانوذرات در این نمونهها باعث بهبود خواص میشوند [1]. کاهش آگلومره شدن



در دمای زینتر ۲۱۵۰ درجه سانتیگراد



شکل (۸): تصویر الکترونهای ثانویه از توزیع غیریکنواخت ذرات SiC در نمونههای: (الف): ZrB2-15%SiCnano-5%SiC و (ب): ZrB2-5%SiCnano-15%SiC

ذرات منجر به بهبود رفتار زینتر بدون فشار و فرآیند چگالش می شود.



شکل (۶): مقادیر دانسیته نسبی برحسب تغییرات درصد حجمی SiC نانو و میکرون در دمای زینتر ۲۱۵۰ درجه سانتیگراد

در نمودار رسم شده در شکل ۷، مشاهده می شود که میزان سختی در نمونه ها با افزایش درصد حجمی SiC نانو و میکرون ابتدا افزایش یافته و سپس با شیب تندی از نمونه ZS15/5 به نمونه ZS5/15 کاهش می یابد، که می توان آن را به تجمع ذرات در مرز دانه ها و غیر یکنواختی توزیع افزودنی SiC میکرون در مقادیر بالا در زمینه نسبت داد، که در تصویر MEK (شکل ۸) آن را می توان مشاهده کرد. همانطور که دیده می شود تغییرات سختی با افزودن ۵ درصد حجمی SiC میکرون افزایش می یابد دلیل این امر کاهش پدیده آگلومراسیون (شکل ۸) و در نتیجه کاهش میزان تخلخل در این نمونه ها نسبت به نمونه های فاقد ذرات میکرومتری است که دانسیته نسبی به ۸۵/۱ درصد می-رسد، با افزایش دانسیته و بهبود چگالش نمونه ها، سختی افزایش می یابد و به مرز GPa میرسد.

در شکل ۹ نمودار تغییرات تافنس شکست نمونه ها بر حسب تغییرات در صد حجمی SiC نانو و میکرون رسم شده است. در شکل ۱۰ نیز اثر فرورونده ویکرز و ترک به وجود آمده در آن نمایش داده شده است. همانطور که دیده می شود با افزایش در صد حجمی SiC میکرون، تافنس شکست تا ۵ در صد افزودن SiC میکرون افزایش وسپس سیر نزولی طی می کند.



شکل (۹): مقادیر تافنس شکست برحسب تغییرات درصد حجمی SiC نانو و میکرون در دمای زینتر ۲۱۵۰ درجه سانتیگراد



شکل (۱۰): اثر فرورونده ویکرز در نمونه ZS15/5

رفتار تافنس شکست را میتوان با استفاده از تاثیرات متقابل ذرات SiC و ترک توجیه کرد. در برخورد ترک با ذرات SiC

دو حالت ممکن است رخ دهد. اول آنکه ترک ذره را بشکند و دوم آنکه ترک ذره را دور بزند و حلقههایی از ترک را در اطراف ذره بوجود آورد. در حالت اول، ترک باید انرژی بسیار زیادی داشته باشد. در نتیجه شکستها از نوع درون دانهای خواهد بود که این امر منجر به کاهش تافنس می شود. در حالت دوم، ترک انرژی کافی برای شکست دانه را ندارد و در نتیجه وارد مرز دانه شده و دانه را دور میزند (شکل ۱۱). این امر منجر به افزایش تافنس می شود.



گزارش شده است [۸] یکی از عوامل مؤثر بر تغییرات تافنس شکست نمونهها، تنشهای باقیمانده ناشی از تفاوت ضرایب اندازه گیری خواص مکانیکی نمونه ها بیشترین سختی و تافنس شکست نیز در ترکیب دارای به ترتیب ۱۵ و ۵ درصد حجمی SiC نانو و میکرون و با مقادیر ۱۵/۹Gpa و ۴/۹ Mpa.m^{1/2} مشاهده شد.

٥- مراجع

- S. Q. Guo "Densification of ZrB2-Based Composites and Their Mechanical and Physical Properties: A Review", Journal of Europian Ceramic Society., Vol. 29, pp. 995-1011, 2009.
- [2] J. F. Justin & A. Jankowiak, "Ultra High Temperature Ceramics: Densification, Properties and Thermal Stability", Onera journal, Vol. 3, pp. 1-11, 2011.
- [3] J. Han, et al., "Oxidation-resistant ZrB2–SiC composites at 2200°C", Composites Science and technology, Vol. 68, No. 3, pp. 799-806, 2008.
- [4] M. S. Asl & M. G. Kakroudi, "Fractographical assessment of densification mechanisms in hot pressed ZrB2-SiC composites", Ceramics International, Vol. 40, No. 9, pp. 15273-15281, 2014.
- [5] H. J. Li, Y. L. Zhang, Q. G. Fu, K. Z. Li, Jian Wei & D. S. Hou, "Oxidation behavior of SiC Nanoparticle-SiC oxidation protective coating for carbon/carbon composites at 1773 K Carbon", Vol. 45, pp. 2692–2716, 2007.

[۶] ن. احمدی، ح. ر. بهاروندی و ن. احسانی، "بررسی تأثیر نانو کاربید بور بر خواص مکانیکی کامپوزیت B4C-5vol%TiB2 به روش زینتر بدون فشار "، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال دهم، شماره سوم، صفحه ۱۴۲–۱۳۵، یایز ۱۳۹۵.

- [7] Z. Nasiri, M. Mashhadi & A. Abdollahi, "Effect of short carbon fiber addition on pressureless densification and mechanical properties of ZrB2– SiC–Csf nanocomposite", Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 51, pp. 216–223, 2015.
- [8] S. Johnson, M. Gasch & M. Stackpoole, "Assessment of the state of the art of ultra high temperature ceramics", 2009.
- [9] M. Cao, S. Wang & W. Han, "Influence of nanosized SiC particle on the fracture toughness of

انبساط حرارتی SiC و ZrB2 (به ترتیب ۴C×۱۰ ⁻⁶/۰ و C ۱۰×۵/۵) باشد. این تفاوت در ضرایب انبساط حرارتی (که منجر به ایجاد تنش باقیمانده می شود) بخشی از آن بصورت فشاری و بخشی از آن بصورت کششی است. تنش باقیمانده فشاری باعث استحكام بخشي مرزدانه ها مي شود اما تنش باقيمانده كششي دانه-های زمینه را تضعیف می کند. در مورد کامیوزیت -ZrB2 SiCnano-5% SiC به دلیل وجود مقدار کافی از نانوذرات در نواحی مرزدانهای به نظر می رسد میزان تنش فشاری بیشتر باشد. این مسئله باعث افزایش استحکام مرزدانهها خواهد شد. در این حالت مرزدانه ها به دلیل داشتن استحکام کافی می توانند مانع رشد ترک شده و تافنس را افزایش دهند [۹–۱۰]. در درصدهای کمتر SiC نانو (کمتر از ۱۵ درصد حجمی)، به نظر می رسد که تنش کششی بر تنش فشاری غلبه کرده و باعث کاهش استحکام مرزدانهای می شود. بنابراین ترک به راحتی از طریق مرزدانه رشد کرده و تافنس شکست کاهش می یابد[۱۱–۱۲]. در مقادیر بیش از ۱۵ درصد حجمی نیز اگرچه به دلیل بی نظمی به وجود آمده در مرزدانه (ناشی از پدیده آگلومراسیون) تقریباً تنش باقیمانده وجود ندارد اما همین بی نظمی باعث کاهش پیوندهای مرزدانه-ای شده و تافنس شکست را کاهش می دهد[۱۱].

٤- نتيجه گيري

در این تحقیق تأثیر حضور همزمان ذرات SiC نانو و میکرون بر رفتار زینتر بدون فشار و خواص مکانیکی کامپوزیت ZrB2-SiC مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که با تغییر درصد محجمی SiC نانو از ۲۰ درصد حجمی به ۱۵ درصد و ۵ درصد میکرون، دانسیته نسبی افزایش یافته و به مقدار ۹۵/۱ درصد می رسد. دلیل این مسئله آن است که نانو ذرات SiC در اطراف زدات SiC میکرون تجمع کرده و تا حدود زیادی از آگلومره شدن آنها جلوگیری میکند. به عبارت بهتر ذرات SiC میکرون مانع آگلومره شدن بیش از حد نانوذرات شده و با توزیع یکنواخت تر فاز تقویت کننده نانومتری در زمینه، فرآیند چگالش و رفتار زینتر بهبود مییابد. با بررسی ریز ساختار و

ZrB2-based nanocomposite ceramic", Materials Science and Engineering, Vol. 527A, pp. 2925– 2928, 2010.

- [10]Z. Nasiri & M. Mashhadi, "Effect of sintering temperature and SiC particles size on the microstructure and mechanical properties of ZrB2-SiC composites", 1st international symposium on nano technology, Isfahan, Iran, 2016.
- [11]Z. Nasiri & M. Mashhadi, "Microstructure and mechanical behavior of ternary phase ZrB₂-SiC-AlN nanocomposite", Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 78, pp. 186–192, 2016.
- [۱۲] ع. علیزاده، ع. ر. عبدالهی و ز. نصیری، "مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al-B4C تولید شده به روش های ریخته گری گردابی، متالورژی پودر و آلیاژسازی مکانیکی"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره هشت، شماره اول، صفحه ۲۹-۱۲، بهار ۱۳۹۳.

Investigation on microstructure, mechanical properties and pressureless sintering behavior of ZrB2-SiCnano/micron composites

Zeynab Nasiri¹, Mehri Mashhadi^{*2}

1- Ph.D. Student, Faculty of Materials & Manufacturing Processes, Malek-e-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2- Assistant Prof., Faculty of Materials & Manufacturing Processes, Malek-e-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

*Corresponding author: me_mashadi@yahoo.com

Abstract

In the present paper, ZrB₂-SiC was developed by pressureless sintering method and SiC powder at nano and micro-sized scale was used as reinforcement phase. In order to produce composite samples, the primary powders were milled and blended in planetary ball mill apparatus with rotational speed of 200rpm and then processed using hot pressing (70°C and 70MPa), cold isostatic press (200MPa), Pyrolysis (1000°C) and sintering (2150°C). The values of relative density and porosity of samples were measured to evaluate the effect of presence of micro-sized SiC and SiC nano particles simultaneously on the pressureless sintering behavior of ZrB₂-SiC. In order to compare the microstructure and mechanical properties of samples Scanning Electron microscopy (SEM), equipped with EDS spectroscopy, XRD analysis, hardness and toughness tests were used. The results show that as the volume percentage of nano SiC decreases to 15 vol.%, the hardness, toughness, relative density and shrinkage initially increase and then decrease.

Keywords: Ultra High Temperature Ceramics, ZrB2-SiC Nano/Micron Composites Pressureless Sintering, Mechanical Properties.

Journal homepage: ma.iaumajlesi.ac.ir

Please cite this article using:

Zeynab Nasiri, Mehri Mashhadi, Investigation on microstructure, mechanical properties and pressureless sintering behavior of ZrB2-SiCnano/micron composites, in Persian, New Process in Material Engineering, 2018, 12(3), 81-90.